

平成 24 年 7 月 5 日

お客様各位

東京エレクトロデバイス株式会社
設計開発センター 生産管理部
部長 成田 隆

TE7720PF 前工程製造ライン および 組立材料 変更のご連絡

拝啓

貴社益々ご清栄のこととお喜び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、貴社にてご採用頂いておりますTE7720PFにつきまして、先般よりご連絡させて頂いておりました6インチウエハーから8インチウエハーへの移管とそれに伴う組立材料の変更がございます。下記にご報告させて頂きまますので、宜しく願い申し上げます。

内容につきましてご確認の上、返信用用紙にご捺印を頂き、お手数ですがご返信頂きたく存じます。

尚、本件は、本件移管の遅延に伴う前工程製造ライン変更(平成 23 年 10 月 24 日付 文章番号 TDGS27098 にて既報)実施後の変更となりますのでご理解の程宜しくお願い致します。

敬具

< 記 >

1. 対象型格：TE7720PF

2. 変更内容：

1) 前工程生産ラインおよび Wafer 径変更；

【変更前】大分6インチ Wafer (φ 150 mm)

【変更後】岩手8インチ Wafer (φ 200 mm)

*Wafer 変化点 (5M1E)

5M1E		〈変更前〉大分6インチ	〈変更後〉岩手8インチ
Man(人)		作業者は異なりますが、作業者認定教育に基づき、同じ教育体制で管理しております。	
Machine(機械)		同一性能機種を使用しております。	
Measurement(測定方法)		定期校正、及び相関性を確認し、同性能であることを確認しております。	
Method (方法)	層間膜平坦	メルト	CMP(Chemical Mechanical Polishing)
	多層形成	Cont:スルーホール Via 平坦化:EB	Cont:W-Plug Via 平坦化:CMP
	作業	SMIF(Standard of Mechanical Interface)に関わる作業以外は同等です。	
Material(材料)		8インチ Wafer 材料を使用し、それ以外は同一材料を使用いたします。	
		Al-Si-Cu	Al-Cu(8インチ既存)
Equipment (環境)	清浄度レベル	Class100	SMIF 対応(内部:Class1 以下)
	システム	生産/品質管理など同等システムを使用しております。	

2) ボンディングワイヤ・モールド樹脂材料の変更；

【変更前】ボンディングワイヤ；Au 材、モールド樹脂；エポキシ Type-B

【変更後】ボンディングワイヤ；Cu 材、モールド樹脂；エポキシ Type-C

* 材料変更により製品に含まれる化学物質情報(成分表)は変更となりますが、型格、電気的特性、パッケージ寸法、実装保証条件などの製品仕様の変更はございません。

3. 変更理由：製品安定供給および材料統一による生産性向上。

4. 移管時期：2013年7月頃

弊社の在庫状況により、実施時期が多少前後することがございます。

詳細は、別途ご連絡させていただきます。

5. 識別方法：ロットナンバーにて識別可能です。詳細は、別途ご連絡させていただきます。

返却用

TDGS28048

平成 24 年 7 月 5 日

お客様各位

東京エレクトロデバイス株式会社
設計開発センター 生産管理部
部長 成田 隆**TE7720PF 前工程製造ライン および 組立材料 変更のご連絡**

拝啓

貴社益々ご清栄のこととお喜び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、貴社にてご採用頂いておりますTE7720PFにつきまして、前工程製造ライン および 組立材料の変更がございます。下記の通りご報告させていただきますので、宜しくお願ひ申し上げます。

内容につきましてご確認の上、返信用用紙にご捺印を頂き、お手数ですがご返信頂きたく存じます。

尚、本件は、本件移管の遅延に伴う前工程製造ライン変更(平成 23 年 10 月 24 日付 文章番号 TDGS27098 にて既報)実施後の変更となりますのでご理解の程宜しくお願ひ致します。

敬具

< 記 >

1. 対象型格：TE7720PF

2. 変更内容：

1)前工程生産ラインおよび Wafer 径変更；

【変更前】大分6インチ Wafer (φ150mm)

【変更後】岩手8インチ Wafer (φ200mm)

*Wafer 変化点 (5M1E)

5M1E		〈変更前〉大分6インチ	〈変更後〉岩手8インチ
Man(人)		作業者は異なりますが、作業者認定教育に基づき、同じ教育体制で管理しております。	
Machine(機械)		同一性能機種を使用しております。	
Measurement(測定方法)		定期校正、及び相関性を確認し、同性能であることを確認しております。	
Method (方法)	層間膜平坦	メルト	CMP(Chemical Mechanical Polishing)
	多層形成	Cont:スルーホール Via 平坦化:EB	Cont:W-Plug Via 平坦化:CMP
	作業	SMIF(Standard of Mechanical Interface)に関わる作業以外は同等です。	
Material(材料)		8インチ Wafer 材料を使用し、それ以外は同一材料を使用いたします。	
		Al-Si-Cu	Al-Cu(8インチ既存)
Equipment (環境)	清浄度レベル	Class100	SMIF 対応(内部:Class1 以下)
	システム	生産/品質管理など同等システムを使用しております。	

2)ボンディングワイヤ・モールド樹脂材料の変更；

【変更前】ボンディングワイヤ；Au材、モールド樹脂；エポキシ Type-B

【変更後】ボンディングワイヤ；Cu材、モールド樹脂；エポキシ Type-C

*材料変更により製品に含まれる化学物質情報(成分表)は変更となりますが、型格、電気的特性、パッケージ寸法、実装保証条件などの製品仕様の変更はございません。

3. 変更理由：製品安定供給および材料統一による生産性向上。

4. 移管時期：2013年7月頃

弊社の在庫状況により、実施時期が多少前後することがございます。

詳細は、別途ご連絡させていただきます。

5. 識別方法：ロットナンバーにて識別可能です。詳細は、別途ご連絡させていただきます。

貴社受領印欄	
日付：	_____
貴社名：	_____
部署名：	_____
ご署名：	_____ 印

東京エレクトロデバイス株式会社
設計開発センター 生産管理部